10/52258

#### (12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum Internationales Büro



### T (BERT BINDER IN BERTE KIND BERT BERK BIED FAN IN BERTE NEW GERIN BIEN IER EIN BERTEN IERD KIN BER

(43) Internationales Veröffentlichungsdatum 26. Februar 2004 (26.02.2004)

**PCT** 

## (10) Internationale Veröffentlichungsnummer WO 2004/017476 A3

(51) Internationale Patentklassifikation7: H01L 23/473

\_\_\_\_

PCT/DE2003/001906

(21) Internationales Aktenzeichen:

(22) Internationales Anmeldedatum:

10. Juni 2003 (10.06.2003)

(25) Einreichungssprache:

Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache:

Deutsch

(30) Angaben zur Priorität: 102 34 704.2 30

30. Juli 2002 (30.07.2002) DE

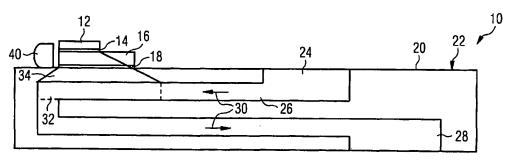
(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von US): OSRAM OPTO SEMICONDUCTORS

GMBH [DE/DE]; Wernerwerkstrasse 2, 93049 Regensburg (DE).

- (72) Erfinder; und
- (75) Erfinder/Anmelder (nur für US): GROETSCH, Stefan [DE/DE]; Richard-Wagner-Strasse 6, 93055 Regensburg (DE).
- (74) Anwalt: EPPING HERMANN FISCHER PATENTAN-WALTSGESELLSCHAFT MBH; P.O. Box 200734, 80007 München (DE).
- (81) Bestimmungsstaaten (national): CH, JP, US.
- (84) Bestimmungsstaaten (regional): europäisches Patent (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR).

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

- (54) Title: SEMICONDUCTOR DEVICE WITH A COOLING ELEMENT
- (54) Bezeichnung: HALBLEITERVORRICHTUNG MIT KÜHLELEMENT



(57) Abstract: The invention relates to a semiconductor device with a semiconductor element (12), in particular, a power laser diode bar, arranged on a cooling element (20), whereby said cooling element (20) comprises a cooling channel (26) in the interior thereof, for the introduction of a coolant. The cooling channel (26) comprises microstructures in at least one region (32) for an effective heat transfer to the coolant. The semiconductor element (12) essentially completely overlaps the region (32) of the cooling channel (26) comprising the microstructures. An intermediate support (16) is arranged between the semiconductor element (12) and the cooling element (20), which is arranged and embodied to compensate for the mechanical tensions arising between the semiconductor element (12) and the cooling element (20) as a result of differing thermal expansions of the semiconductor element (12) and the cooling element (12). The material of the cooling element (20) has a particularly preferred high modulus of elasticity such that the compensation essentially occurs within the elastic expansion region.

(57) Zusammenfassung: Halbleitervorrichtung mit einem Halbleiterbauelement (12), insbesondere einem Leistungs-Laserdiodenbarren, das auf einem Kühlelement (20) angeordnet ist, wobei das Kühlelement (20) in seinem Inneren einen Kühlkanal (26) zum Führen eines Kühlmittels enthält. Der Kühlkanal (26) weist in zumindest einem Bereich (32) Mikrostrukturen für einen effektiven Wärmeübergang zum Kühlmittel auf. Das Halbleiterbauelement (12) überlappt im Wesentlichen vollständig mit dem die Mikrostrukturen aufweisenden Bereich (32) des Kühlkanals (26). Zwischen dem Halbleiterbauelement (12) und dem Kühlelement (20) ist ein Zwischenträger (16) angeordnet, der derart eingerichtet und ausgelegt ist, dass er aufgrund von unterschiedlichen thermischen Ausdehnungen von Halbleiterbauelement (12) und Kühlelement (20) auftretende mechanische Spannungen zwischen Halbleiterbauelement (12) und Kühlelement (20) kompensiert. Das Material des Kühlelements (20) weist besonders bevorzugt einen derart hohen Elastizitätsmodul auf, dass die Kompensation im Wesentlichen im elastischen Dehnungsbereich erfolgt.



onales Aktenzeichen DE 03/01906

# a. Klassifizierung des anmeldungsgegenstandes IPK 7 H01L23/473

Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK

#### B. RECHERCHIERTE GEBIETE

Recherchlerter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole )

IPK 7 H01L IPK 7

Recherchierte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, sowelt diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Während der Internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)

EPO-Internal, WPI Data, INSPEC, COMPENDEX

<b>-</b>		SENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN  Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Bett. Anspruch Nr.	
· [ ]	Kategorie*	1/	0	
NO1	X	US 5 812 570 A (SPAETH WERNER)	8	
	A	Spalte 2, Zeile 45 - Zeile 55 Abbildung 1 Zusammenfassung	7-15	
202	X	EP 0 509 825 A (NIPPON ELECTRIC CO) 21. Oktober 1992 (1992-10-21) Spalte 7, Zeile 28 - Zeile 38	7	
103	X	US 2002/063329 A1 (ARAI NOBUHIRO ET AL) 30. Mai 2002 (2002-05-30) Absatz '0076! Absatz '0102!	7	
		_/_		
	•			

Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu	Siehe Anhang Patentiamilia
entnehmen :	T' Spätere Veröffentlichung, die nach dem Internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritälsdallum veröffentlicht worden ist und mit der oder dem Prioritälsdallum veröffentlicht worden ist und mit der
"A" Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der ist in der ist in der in de	Anmeldung nicht kölligiert. Sondern har Zum der ihr zugrundellegenden Erfindung zugrundellegenden Prinzips oder der ihr zugrundellegenden
E' Elteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen     Anmeldedatum veröffentlicht worden ist     Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifsihaft er-	*X" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung die bealischte als neu oder auf

\*L\* Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsenspruch zweifelhaft er-scheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie

soll oder de alle steen de steen steen steen en steen steen

Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderlicher Tätigkeit beurhend betrachtet kann nicht als auf erfinderlichung mit einer oder mehreren anderen werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategoris in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann nahelliegend ist

'&' Varöffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist

Datum des Abschlusses der Internationalen Recherche

.8. November 2004

Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde

Europäisches Patentiams, P.B. 5818 Patentiam 2 NL – 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl. Fax: (+31-70) 340-3016

Absendedatum des Internationalen Recherchenberichts

06/12/2004

Bevollmächtigter Bediensteter

Bésuelle, E

Formbian PCT/ISA/210 (Blain 2) (Januar 2004)

3

19:19 EPPING HERMANN FISCHER
INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

DE 03/01906

		DE 03/01906
C (Fortretzu	ng) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN	e Betr, Anspruch Nr.
Kalsgorie*	ng) ALS WESEN I DON'T AND METERS AND AND AND METERS AND	Betr, Anspruch Nr.
X	KERNS J A ET AL: "DYMALLOY: A COMPOSITE SUBSTRATE FOR HIGH POWER DENSITY ELECTRONIC COMPONENTS" INTERNATIONAL JOURNAL OF MICROCIRCUITS AND ELECTRONIC PACKAGING, INTERNATIONAL MICROELECTRONICS & PACKAGING SOCIETY, US, Bd. 19, Nr. 3, 1. Juli 1996 (1996-07-01), Seiten 206-211, XP000639483 ISSN: 1063-1674	9
x	das ganze Dokument  W.B. JOHNSON ET AL.:  JOURNAL OF MATERIALS RESEARCH,  Bd. 8, Nr. 5, Mai 1993 (1993-05), Seiten	9
X	Zusammenfassung  FP 0 771 604 A (NERACHER ARNOLD)	9
	7. Mai 1997 (1997-05-07) Zusammenfassung Spalte 2, Zeile 54 - Zeile 59	9
X	INAL O T ET AL: "Fabrication and characterization of diamond/copper composites for thermal management substrate applications" MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING B, ELSEVIER SEQUOIA, LAUSANNE, CH, Bd. 41, Nr. 2, 1. November 1996 (1996-11-01), Seiten	
	261-266, XP004049585 ISSN: 0921-5107 Zusammenfassung	
l		

19:20 INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT Angeben zu Veröffentlich

jonales Aktanzeichen DE 03/01906

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument		Datum der Veröffentlichung		Mkglied(er) der Patentiamilie	Datum der Veröffentlichung
US 5812570	A	00 00 1009	DE DE EP JP JP TW	19536463 A1 59609046 D1 0766354 A1 3386963 B2 9129986 A 383516 B	03-04-1997 16-05-2002 02-04-1997 17-03-2003 16-05-1997 01-03-2000
EP 0509825	A	21-10-1992	EP JP US	0509825 A2 5074985 A 5291064 A	21-10-1992 26-03-1993 01-03-1994
US 2002063329	A1	30-05-2002	CN GB JP	1359177 A 2373636 A ,B 2002232068 A	17-07-2002 25-09-2002 16-08-2002
EP 0771604		07-05-1997	EP	0771604 A1	07-05-1997